

SPECIFICATION TRANSISTORS,
DIODES

NO. 17-2T-1321

2SC1361・2SC1362

PAGE: 2/7 / 173

Low Noise 用

DATE: / /

1. 構造 NPN APM型 シリコントランジスタ
 2. 用途 高周波増巾, スイッチング, 低雑音増巾
 3. 外形 付 図 (JEDEC TO-92 類似)

4. 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
- | | | |
|--|---------|---------|
| | 2SC1361 | 2SC1362 |
|--|---------|---------|

コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	25V	50V
-------------	-----------	-----	-----

コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	25V	50V
--------------	-----------	-----	-----

エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	6V
-------------	-----------	----

コレクタ電流	I_C	200mA
--------	-------	-------

コレクタ損失	P_C	320mW
--------	-------	-------

ジャンクション温度	T_j	120°C
-----------	-------	-------

保存温度	T_{stg}	-30°C ~ +115°C
------	-----------	----------------

5. 電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	記 号	条 件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C=2mA$ 2SC1361 2SC1362	25 50			V
コレクタ遮断電流	I_{CB0}	$V_{CB}=25V, I_E=0$			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I_{EB0}	$V_{EB}=6V, I_C=0$			1.0	μA
直流電流増巾率	h_{FE}	$I_C=1mA, V_{CE}=3V$	129		690	
コレクタ・エミッタ 間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=50mA$		0.10	0.30	V
ベース・エミッタ 間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_B=10mA$		0.85	1.20	V
小信号電流増巾率	$ h_{fe} $	$V_{CE}=6V, I_E=-2mA$ $f=100MHz$	1.0	3.0		dB
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=6V, I_E=0$ $f=1MHz$		4.5	7.0	pF
$C_c \cdot r_{bb'}$	$C_c \cdot r_{bb'}$	$V_{CB}=6V, I_E=-2mA$ $f=159MHz$		300	600	pS
雑音指数	NF	$V_{CE}=6V, I_E=-1mA$ $R_g=500\Omega, f=1KHz$		4.5	6.0	dB
出力抵抗	R_O	$V_{CE}=1V, I_C=20mA$ $f=1KHz$	350			Ω

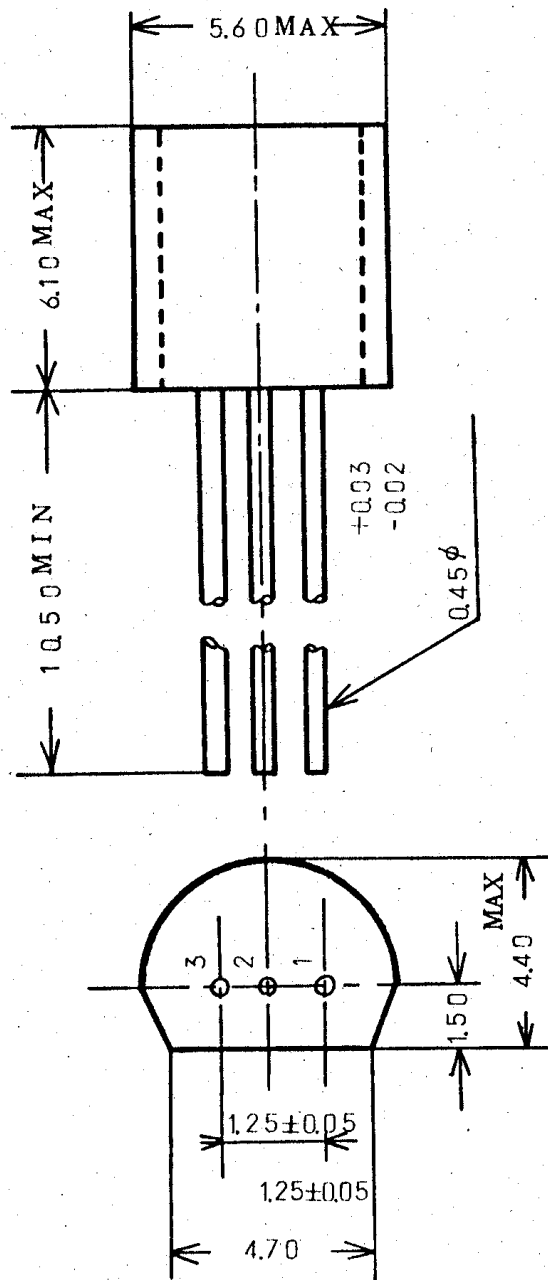
6. 規格細分類 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

製品名	h_{FE} ($I_C = 1\text{mA}$, $V_{CE} = 3\text{V}$)
2SC1361-6 2SC1362-6	129 ~ 276
2SC1361-7 2SC1362-7	204 ~ 442
2SC1361-8 2SC1362-8	326 ~ 690

2SC1361, 2SC1363

外形図 (JEDEC TO-92 類似)

2SC1362, 2SC1364



単位: mm

電極接続

1. エミッタ
2. コレクタ
3. ベース